

拒絶理由通知書

(担) 山下様

特許出願の番号	平成11年 特許願 第263742号
起案日	平成15年12月10日
特許庁審査官	松嶋 秀忠 9836 4M00
特許出願人代理人	鈴江 武彦(外 6名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

16.2.14

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項 1 - 3

理由 1, 2

引用文献 1 - 5

備考:

特に、引用文献1の第2図及びその説明箇所、引用文献2の第1図、第4図及びその説明箇所、引用文献3の図1及びその説明箇所、引用文献4の特許請求の範囲及び第2図、引用文献5の第1図及びその説明箇所を参照されたい。

引用文献1乃至5に記載された発明もソース及びドレイン領域のゲート電極近傍における深さよりも深くなる位置に素子分離領域が形成されているものと認められる。

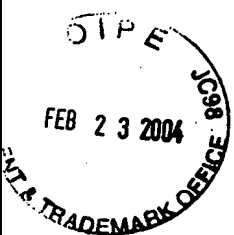
引 用 文 献 等 一 覧

- ## 先行技術文献調査結果の記録

- この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

(Translation)

Mailed: December 16, 2003



NOTIFICATION OF REASONS FOR REJECTION

Patent Application No.: 1999-263742

Examiner's Notice Date: December 10, 2003

Examiner: H. Matsushima

This application is rejected on the grounds stated below. Any opinion about the rejection must be filed within 60 DAYS of the mailing date hereof.

REASONS

1. The invention is unpatentable under Section 29 (1) (iii) of the Patent Law as being described in the following publication distributed in Japan or a foreign country prior to this application.
2. The invention is unpatentable under Section 29 (2) of the Patent Law, as being such that the invention could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of the invention described in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to this application.

REMARKS

Claims 1-3

Reasons 1 and 2

References 1-5

Notes

Please especially refer to Figure 2 and its explanation in Reference 1; Figures 1 and 4 and their explanation in Reference 2, Figure 1 and its explanation in Reference 3, the claims and Figure 2 in Reference 4 and Figure 1 and its explanation in Reference 5.

It is considered that the inventions recited in References 1-5 also include

an element isolation region formed at a deeper level compared to the depth near the gate electrode of the source and the drain regions.

References Cited:

1. Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 02-189976
2. Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 02-130852
3. Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 09-252129
4. Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 04-037048
5. Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 01-276669

Prior Art Search Report

Searched Field: IPC 7th ed. H01L29/ 78
H01L21/ 336

DB Name

Prior-Art Document: Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 08-139325

The result of this prior art search does not constitute the reasons for rejection.